

Japio世界特許情報全文検索サービス（Japio-GPG/FX） サービス改善のお知らせ

株式会社発明通信社

平素は、Japio世界特許情報全文検索サービス（Japio-GPG/FX）をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。この度、以下のサービス改善をさせていただく運びとなりましたのでご案内いたします。

今後もさらにサービス改善を進めてまいりますので、引き続き、ご意見・ご要望等を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

■ご提供開始日（予定） 2023年6月23日（金）

■サービス改善の概要：公報原文データの早期蓄積

公報原文データを機械翻訳文に先行して蓄積することで、現状と比較をして、1週間程度早く検索・閲覧が可能となります。

現在、Japio-GPG/FXでは公報原文と機械翻訳文を同時に蓄積提供しており、機械翻訳処理に時間がかかることから、各国の公報発行から蓄積提供まで2週間から4週間程度のタイムラグが生じておりました。

今回公報原文データのみを早期蓄積提供することで、日本、中国、韓国、アメリカ、EPO、WIPO、ドイツ、イギリス、台湾の公報原文データ（書誌事項、発明の名称、要約文、クレーム、詳細な説明、図面）を、現状と比較をして、1週間程度、短縮してご提供いたします。

（蓄積の詳細は2023年6月23日（金）データ更新の「データ蓄積期間」をご参照願います。）

なお、機械翻訳文の蓄積については、現行のスケジュールでご提供いたします。

今回の公報原文データのための早期蓄積により、機械翻訳文が未蓄積の文献が発生いたします。この場合、検索結果（一覧表示、詳細表示）、ダウンロード、ファイル出力およびMTダウンロードサービス（Japio-GPG/FXの有料オプション）で公報原文データのみが表示（出力）され、機械翻訳文は表示（出力）されませんのでご注意願います。

MTダウンロードサービス（Japio-GPG/FXの有料オプション）では公報原文データのための文献も月ごとのダウンロード件数にカウントされます。検索時に公報発行日として機械翻訳文が蓄積されている期間を指定することにより早期蓄積された公報原文データのみ

の文献の結果を表示させずに、機械翻訳文が含まれる従来の結果表示（出力）ができません。

また、簡易SDI機能につきましては機械翻訳文の蓄積タイミングで更新の扱いとしております。

別紙に各種画面例を掲載しておりますので、こちらをご参照いただけると幸いです。

各種画面例はサンプル画面です。記載されている内容は実際と異なることがあります。また、各種画面例は現時点の情報で、実際のサービス開始では、画面が異なることがありますのでご注意ください。

詳細に関しましては、2023年6月23日に更新されるJapio-GPG/FXのマニュアルをご参照願います。

今回の早期蓄積された公報原文データはAI翻訳サービス（Japio-GPG/FXの有料オプション）での翻訳元データとしてもご利用いただけます。この機会にAI翻訳サービス（Japio-GPG/FXの有料オプション）のご導入をご検討いただくと幸いです。

以上

お問い合わせ先

株式会社発明通信社 HYPAT-i2 サポートデスク

TEL : 03-5281-5514 E-mail: info@hypatweb.jp



■画面例（サンプル）

1. データ蓄積期間

公報原文データの蓄積期間がMT（機械翻訳文）より約1週間、早くなります。

これにより公報原文データでの検索、表示が早く可能になります。

Japio世界特許情報全文検索サービス (Japio-GPG/FX) データ蓄積期間

2023年6月9日 更新

国/地域、機関	データ名	種 別	蓄 積 期 間	
中国	公報 (中国語)	書誌、要約、全文、代表図、全図面	1985/09/10 ~	2023/05/26
	公報 (日本語MT)		1985/09/10 ~	2023/05/19
}	}	}	}	}
日本	公報 (日本語)	書誌、要約・全文、代表図、全図面※2	1983/01/05 ~	2023/05/26
	公報 (英語MT)		1980/01/03 ~	2023/05/19
}	}	}	}	}
アメリカ	公報 (英語)	書誌、要約、全文、代表図、全図面※4	1976/01/06 ~	2023/05/25
	公報 (日本語MT)		1976/01/06 ~	2023/05/18
}	}	}	}	}

「データ蓄積期間」では公報原文データの蓄積期間タイムラグの短縮対象国の公報データについて、公報原文データ（原語）と公報機械翻訳語データ（MT）を分けて表示します。

画面例では公報のMTデータより1週間早く公報原文データが蓄積されています。

以下の画面例では日本、中国の2023年5月20日以降発行、アメリカの2023年5月19日以降発行の公報は、公報原文データのみの蓄積として、例示します。

2. AI 翻訳サービス (Japio-GPG/FX の有料オプション)

AI 翻訳サービスでは公報番号指定で公報原文データのみの文献でも AI 翻訳が可能になり、AI 翻訳が早くご活用になれます。機械翻訳文が表示されない文献でも「AI 翻訳サービス」や詳細表示画面の「AI 翻訳 (公報)」から AI 翻訳を表示できます。

AI翻訳サービス

↓

AI翻訳(公報)

↓

米国の2023年5月25日発行の公報。

公報原文データを早く蓄積し、データを検索、参照することができます。

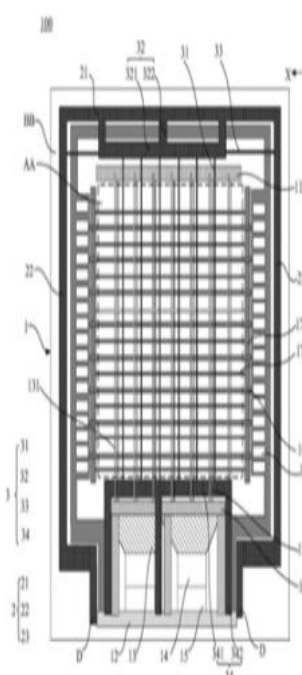
さらに AI 翻訳サービスでは早く蓄積された公報原文データを利用して AI 翻訳が可能になります。

3. 一覧表示

公報原文データが早く検索、表示できるようになります。

[1. CN116171655A](#)
阵列基板及显示装置

出願人: [REDACTED]
発明者: [REDACTED]
出願番号: CN202180002657.X [2021-09-24]
文献番号: [CN116171655A](#) [2023-05-26]
公報PDF フロントPDF 全図面表示
国際出願番号: PCT/CN2021/120354 [2021-09-24]
国際公開番号: [WO2023/044763](#) [2023-03-30]
翻訳文提出日: [2021-09-27]
IPC: H10K59/131[20230101]; H01L27/12[20060101]
パテントファミリー: [ファミリー一覧表示](#)



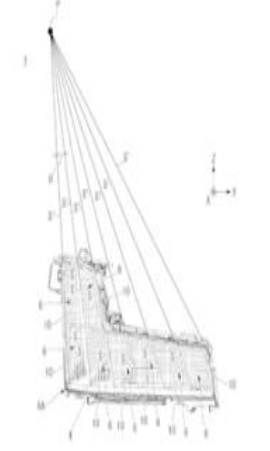
中国の2023年5月26日発行の公報。公報原文データを機械翻訳文データより早く蓄積し、データを検索、参照することができるようになります。

なお、外国文献の機械翻訳文データが未蓄積の文献では発明の名称(MT日本語)、要約文(MT日本語)は、表示されません。

機械翻訳文データは、現状通り次回(通常2週間後)のデータ更新で蓄積、表示されます。

[451. JP2023073767A](#)
車両用灯具

出願人: [REDACTED]
発明者: [REDACTED]
出願番号: JP2021186436 [2021-11-16]
文献番号: [JP2023073767A](#) [2023-05-26]
公報PDF フロントPDF サマリーPDF 全図面表示
IPC: F21S43/31[201801]; F21V7/09[200601]; F21S43/14[201801];
F21W103/35[201801]; F21W103/00[201801]; F21W103/20[201801];
F21W103/45[201801]; F21W103/10[201801]; F21W103/40[201801];
F21W103/55[201801]; F21W102/30[201801]; F21W102/00[201801];
F21Y115/10[201601]; F21Y115/30[201601]
要約(日): 【課題】 発光の見栄えを良くすることを可能とした車両用灯具を提供する。
【解決手段】 複数のリフレクタ6の少なくとも一部が一方向に並んで配置されることによって、複数のリフレクタ6を正面視したときに、複数のリフレクタ6の反射面10が一方向に並ぶ1つの発光領域Eを構成しており、発光領域Eは、一方向に並ぶ反射面10の各境界線Sを光源Sが位置する方向に延長した延長線S'が1つの交点において交差するように形成され、延長線S'が一方向に並ぶ反射面10の各境界線Sとして区画して構成されている。
【選択図】 図4
パテントファミリー: [ファミリー一覧表示](#)



日本の2023年5月26日発行の公報。公報原文データを機械翻訳文データより早く蓄積し、データを検索、参照することができるようになります。

なお、日本文献の機械翻訳文データが未蓄積の文献では発明の名称(MT英語)は、表示されません。

機械翻訳文データは、現状通り次回(通常2週間後)のデータ更新で蓄積、表示されます。

- ・ 検索時に公報発行日に機械翻訳文の蓄積期間を指定することにより機械翻訳文を含めた表示ができます。

4. 詳細表示

公報原文データが早く検索、表示できるようになります。

1. US20230165174A1
SEMICONDUCTOR DEVICES

出願人: [REDACTED]
発明者: [REDACTED]
出願番号: US17638200 (2022-10-05)
文献番号: US20230165174A (2023-05-25)
公開PDF | フロントPDF | バックPDF | 権利情報 | 全図表示
IPC: H01L45/00(20060101); H01L27/24(20060101)

英語/中国語/韓国語 | 日本語

<invention-title>
SEMICONDUCTOR DEVICES

<abstract>
A semiconductor device includes gate electrodes on a substrate, a channel and a resistance pattern. The gate electrodes are spaced apart from each other in a vertical direction substantially perpendicular to an upper surface of the substrate. The channel extends through the gate electrodes in the vertical direction on the substrate. The resistance pattern includes a phase-changeable material. The resistance pattern includes a first vertical extension portion on a sidewall of the channel and extending in the vertical direction, a first protrusion portion on an inner sidewall of the first vertical extension portion and protruding in a horizontal direction substantially parallel to the upper surface of the substrate, and a second protrusion portion on an outer sidewall of the first vertical extension portion and protruding in the horizontal direction and not overlapping the first protrusion portion in the horizontal direction.

<claims>
1. A semiconductor device comprising: gate electrodes on a substrate, the gate electrodes being spaced apart from each other in a vertical direction substantially perpendicular to an upper surface of the substrate; a channel extending through the gate electrodes in the vertical direction on the substrate; and a resistance pattern including a phase-changeable material, the resistance pattern including: a first vertical extension portion on a sidewall of the channel, the first vertical extension portion extending in the vertical direction; a first protrusion portion on an inner sidewall of the first vertical extension portion, the first protrusion portion protruding in a horizontal direction substantially parallel to the upper surface of the substrate; and a second protrusion portion on an outer sidewall of the first vertical extension portion, the second protrusion portion protruding in the horizontal direction and not overlapping the first protrusion portion in the horizontal direction.

2. The semiconductor device of claim 1, wherein the resistance pattern includes a chalcogenide-based material.

3. The semiconductor device of claim 1, wherein the first protrusion portion of the resistance

Fig-EMI-D00000
FIG. 1
Fig-EMI-D00001

米国の 2023 年 5 月 25 日
発行の公報。公報原文データ
を機械翻訳文データより早
く蓄積し、データを検索、参
照することができるように
なります。

なお、機械翻訳文データが
未蓄積の文献では発明の名
称 (MT 日本語、MT 英語)、
全文 (MT 日本語、MT 英語)
は、表示されません。機械翻
訳文データは、現状通り次回
(通常 2 週間後) のデータ更
新で蓄積、表示されます。

1. US20230165174A1
SEMICONDUCTOR DEVICES

出願人: [REDACTED]
発明者: [REDACTED]
出願番号: US17638200 (2022-10-05)
文献番号: US20230165174A (2023-05-25)
公開PDF | フロントPDF | バックPDF | 権利情報 | 全図表示
IPC: H01L45/00(20060101); H01L27/24(20060101)

英語/中国語/韓国語 | 日本語

<invention-title>
SEMICONDUCTOR DEVICES

<abstract>
A semiconductor device includes gate electrodes on a substrate, a channel and a resistance pattern. The gate electrodes are spaced apart from each other in a vertical direction substantially perpendicular to an upper surface of the substrate. The channel extends through the gate electrodes in the vertical direction on the substrate. The resistance pattern includes a phase-changeable material. The resistance pattern includes a first vertical extension portion on a sidewall of the channel and extending in the vertical direction, a first protrusion portion on an inner sidewall of the first vertical extension portion and protruding in a horizontal direction substantially parallel to the upper surface of the substrate, and a second protrusion portion on an outer sidewall of the first vertical extension portion and protruding in the horizontal direction and not overlapping the first protrusion portion in the horizontal direction.

<claims>
1. A semiconductor device comprising: gate electrodes on a substrate, the gate electrodes being spaced apart from each other in a vertical direction substantially perpendicular to an upper surface of the substrate; a channel extending through the gate electrodes in the vertical direction on the substrate; and a resistance pattern including a phase-changeable material, the resistance pattern including: a first vertical extension portion on a sidewall of the channel, the first vertical extension portion extending in the vertical direction; a first protrusion portion on an inner sidewall of the first vertical extension portion, the first protrusion portion protruding in a horizontal direction substantially parallel to the upper surface of the substrate; and a second protrusion portion on an outer sidewall of the first vertical extension portion, the second protrusion portion protruding in the horizontal direction and not overlapping the first protrusion portion in the horizontal direction.

2. The semiconductor device of claim 1, wherein the resistance pattern includes a chalcogenide-based material.

3. The semiconductor device of claim 1, wherein the first protrusion portion of the resistance

Fig-EMI-D00000
FIG. 1
Fig-EMI-D00001

詳細表示画面で機械翻訳
語 (外国文献では「日本語」、
日本文献では「英語等」) の
みを指定すると全文欄は、表
示されません。

- ・ 検索時に公報発行日に機械翻訳文の蓄積期間を指定することにより機械翻訳文を含めた表示ができます。

公報原文データが早く検索、出力できるようになります。

[illegible]

なお、発明の名称の機械翻訳文データは、未蓄積で出力されません。

[illegible]

また、月ごとのダウンロード件数にはカウントされます。

- ・ 検索時に公報発行日に機械翻訳文の蓄積期間を指定することにより機械翻訳文を含めた出力ができます。